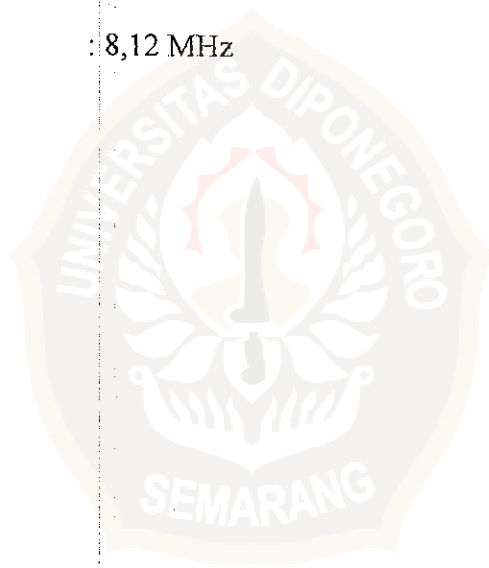


LAMPIRAN



LAMPIRAN A : PARAMETER PROSES PENDEPOSISIAN LAPISAN TIPIS
BAHAN ORGANIK TOLUENA

- a. Jenis sampel : Si p dan Si n
- b. Jarak sampel : 2 cm
- c. Waktu deposisi : 3 menit
- d. Tegangan pendorong : 500 V
- e. Tegangan Einzel : 100 V
- f. Tekanan : 0.07 mbarr
- g. Daya RF : 100 W
- h. Frekuensi : 8,12 MHz



LAMPIRAN B : HASIL PENGUKURAN ARUS TEGANGAN DIODA
PERSAMBUNGAN P-N IN 4007, BY 229, IN 4148

a. Bias maju

NO	TEGANGAN (V)	ARUS (mA)		
		IN 4007	BY 229	IN 4148
1	0	0	0	0
2	0,1	0	0	0
3	0,2	0	0	0
4	0,3	0	0	0
5	0,4	0	0	0
6	0,5	0	0	0
7	0,6	1	1	1
8	0,7	10	18	12
9	0,8	24	40	30
10	0,9	40	70	60

b. Bias mundur

NO	TEGANGAN (V)	ARUS (mA)		
		IN 4007	BY 229	IN 4148
1	0	0	0	0
2	5	0	0	0
3	10	0	0	0
4	15	0	0	0
5	20	0	0	0
6	25	0	0	0
7	30	0	0	0
8	35	0	0	0
9	40	0	0	0
10	45	0	0	0
11	50	0	0	0
12	55	0	0	0
13	60	2	1	2
14	65	15	25	24
15	70	45	60	40

LAMPIRAN C : DATA SEKUNDER HASIL PENGUKURAN ARUS
TEGANGAN DIODA SCHOTTKY Au/Si-n/Ni

a. Bias maju

No	Tegangan (V)	Arus (mA)
1	0	0
2	0,1	0
3	0,2	0
4	0,3	0
5	0,4	0
6	0,5	0
7	0,6	0
8	0,7	1
9	0,8	14
10	0,9	36
11	1,0	62
12	1,1	98

b. Bias mundur

No	Tegangan (V)	Arus (mA)
1	0	0
2	5	0
3	10	0
4	15	0
5	20	0
6	25	0
7	30	0
8	35	0
9	40	0
10	45	0
11	50	0
12	55	0
13	60	2
14	65	10
15	70	40
16	75	90

LAMPIRAN D : HASIL PENGUKURAN ARUS TEGANGAN DIODA SEMIKONDUKTOR ISOLATOR LOGAM (SIL)

a. Semikonduktor tipe p

- Bias maju

NO	TEGANGAN (V)	ARUS (mA)		
		Al/T/Si-p/Al	Cu/T/Si-p/Al	Ag/T/Si-p/Al
1	0	0	0	0
2	0,1	0	0	0
3	0,2	0	0	0
4	0,3	0	0	0
5	0,4	0	0	0
6	0,5	0	0	0
7	0,6	0	0	0
8	0,7	0	0	0
9	0,8	0	0	1
10	0,9	0	1	8
11	1,0	1	14	46
12	1,1	8	36	86
13	1,2	44	68	138
14	1,3	116	100	
15	1,4	256		

- Bias mundur

NO	TEGANGAN (V)	ARUS (mA)		
		Al/T/Si-p/Al	Cu/T/Si-p/Al	Ag/T/Si-p/Al
1	0	0	0	0
2	20	0	0	0
3	40	0	0	0
4	60	0	0	0
5	80	0	0	0
6	100	0	0	0
7	120	0	0	1
8	140	0	1	12
9	160	0	42	24
10	180	1	98	68
11	200	22	176	130
12	220	54	264	240
13	240	126		
14	260	192		

b. Semikonduktor tipe n

- Bias maju

NO	TEGANGAN (V)	ARUS (mA)		
		Al/T/Si-n/Al	Cu/T/Si-n/Al	Ag/T/Si-n/Al
1	0	0	0	0
2	0,1	0	0	0
3	0,2	0	0	0
4	0,3	0	0	0
5	0,4	0	0	0
6	0,5	0	0	0
7	0,6	0	0	0
8	0,7	0	0	0
9	0,8	0	0	0
10	0,9	0	0	0
11	1,0	0	0	0
12	1,1	2	0	0
13	1,2	16	1	0
14	1,3	48	22	1
15	1,4	112	58	26
16	1,5		94	68
17	1,6			124

- Bias mundur

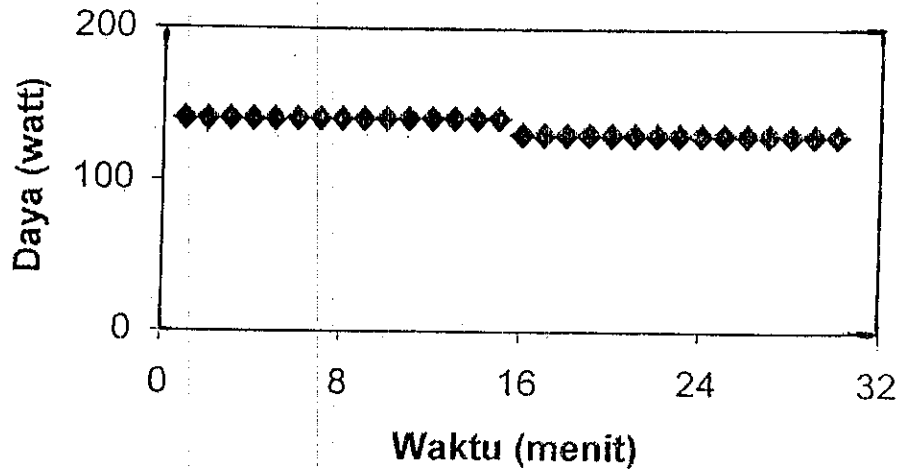
NO	TEGANGAN (V)	ARUS (mA)		
		Al/T/Si-n/Al	Cu/T/Si-n/Al	Ag/T/Si-n/Al
1	0	0	0	0
2	20	0	0	0
3	40	0	0	0
4	60	0	0	0
5	80	0	0	0
6	100	0	0	0
7	120	0	0	0
8	140	0	0	0
9	160	0	0	0
10	180	0	0	0
11	200	1	0	0
12	220	16	1	0
13	240	46	12	1
14	260	82	34	18
15	280		58	50
16	300			92

LAMPIRAN E : PERBANDINGAN TEGANGAN POTONG MASUK DAN TEGANGAN DADAL DIODA PERSAMBUNGAN P-N, DIODA Au/SI-N/Ni, DIODA SIL DENGAN SILIKON TIPE P DAN TIPE N

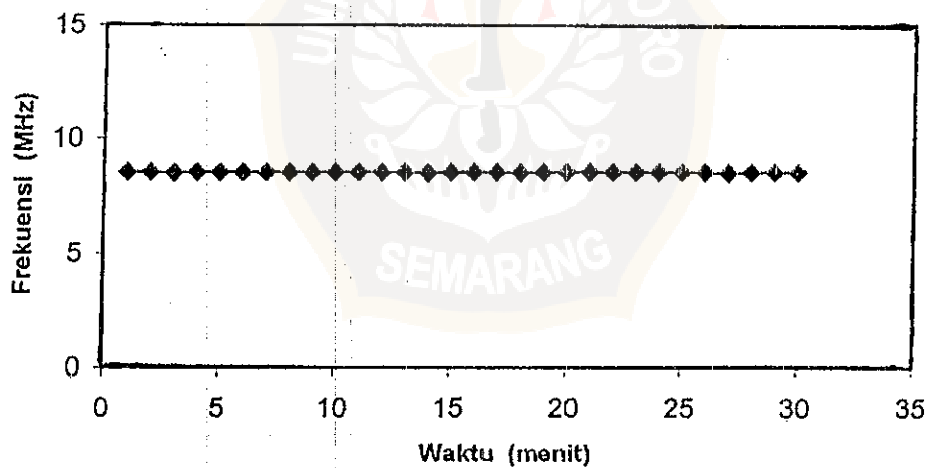
Tabel E : Tegangan potong masuk dan tegangan dadal dioda persambungan p-n, dioda Au/Si-n/Ni, dioda SIL dengan silikon tipe p dan tipe n

No	Jenis Dioda	Tegangan Potong Masuk (V)	Tegangan Dadal (V)
1	IN 4007	0,6	60
2	BY 229	0,6	60
3	IN 4148	0,6	60
4	Au/Si-n/Ni	0,7	60
5	Ag/T/Si-p/Al	0,8	120
6	Cu/T/Si-p/Al	0,9	140
7	Al/T/Si-p/Al	1,0	180
8	Al/T/Si-n/Al	1,1	200
9	Cu/T/Si-n/Al	1,2	220
10	Ag/T/Si-n/Al	1,3	240

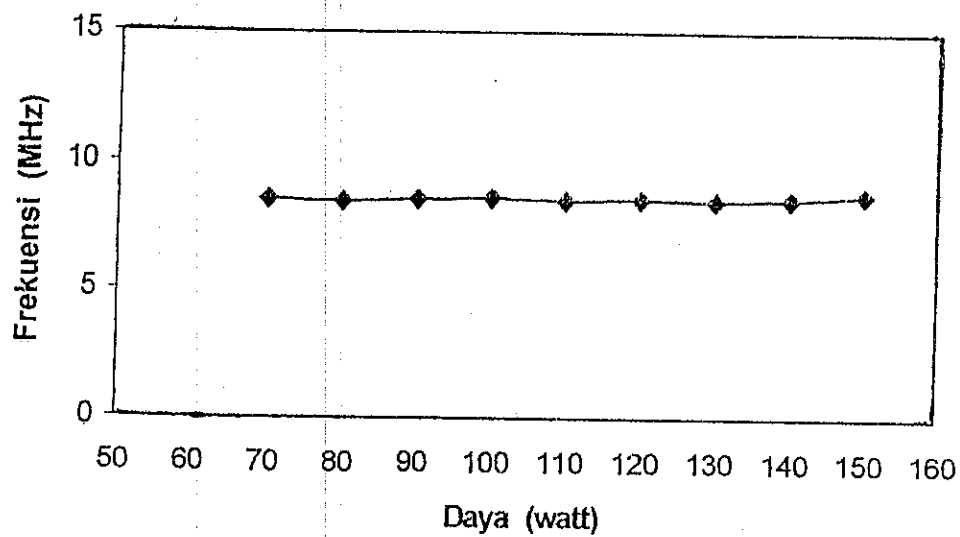
LAMPIRAN F : HASIL PENGUJIAN UNJUK KERJA KESTABILAN RF



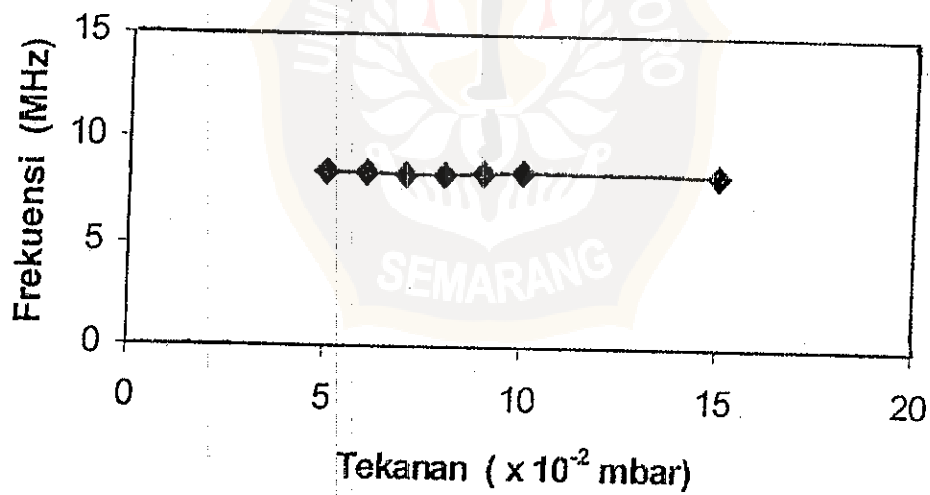
Gambar f-1 : Unjuk kerja kestabilan daya RF



Gambar f-2 : Unjuk kerja kestabilan frekuensi RF

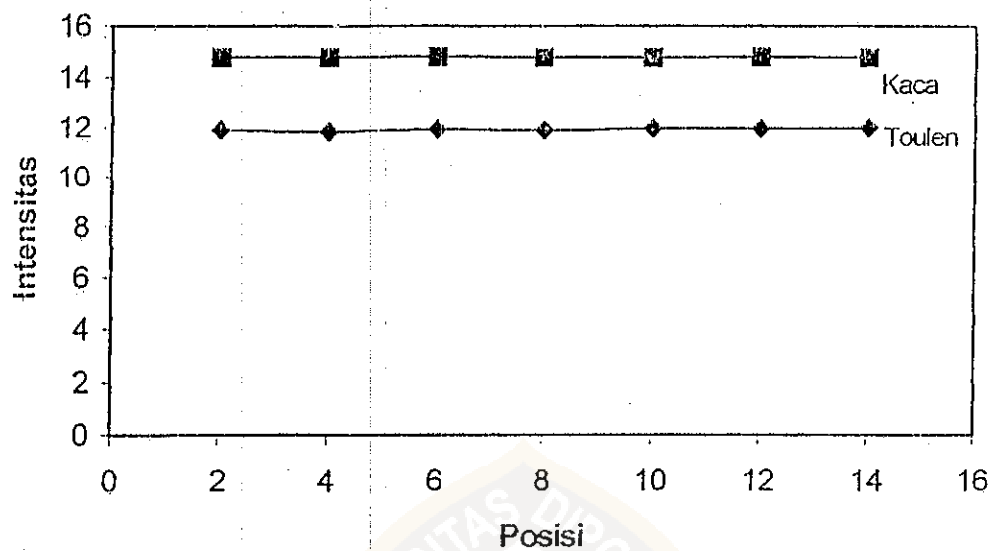


Gambar f-3 : Pengaruh daya terhadap frekuensi RF

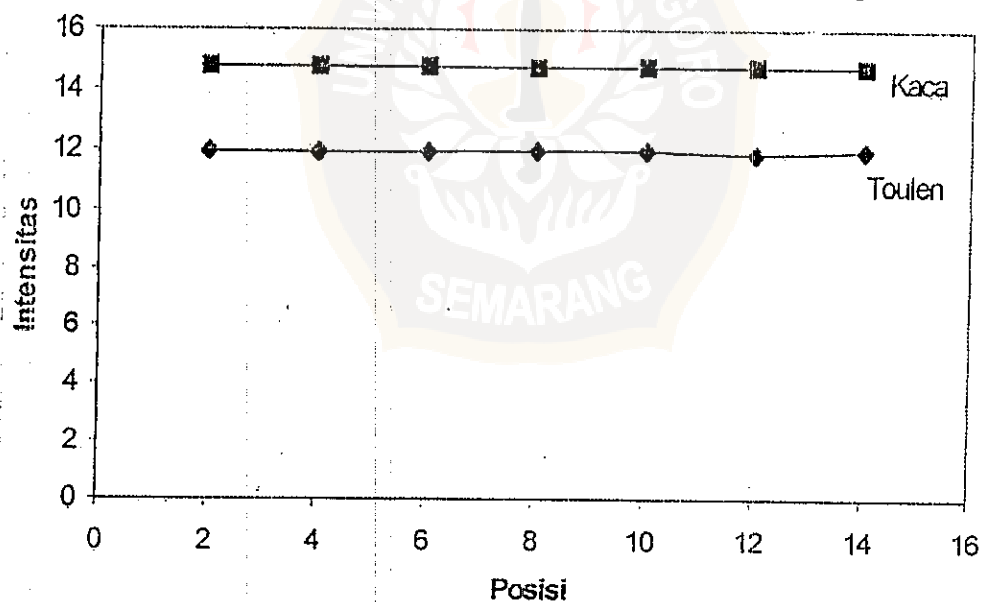


Gambar f-4 : Pengaruh beban terhadap frekuensi RF

LAMPIRAN G : HASIL PENGUJIAN HOMOGENITAS LAPISAN TOLUENA

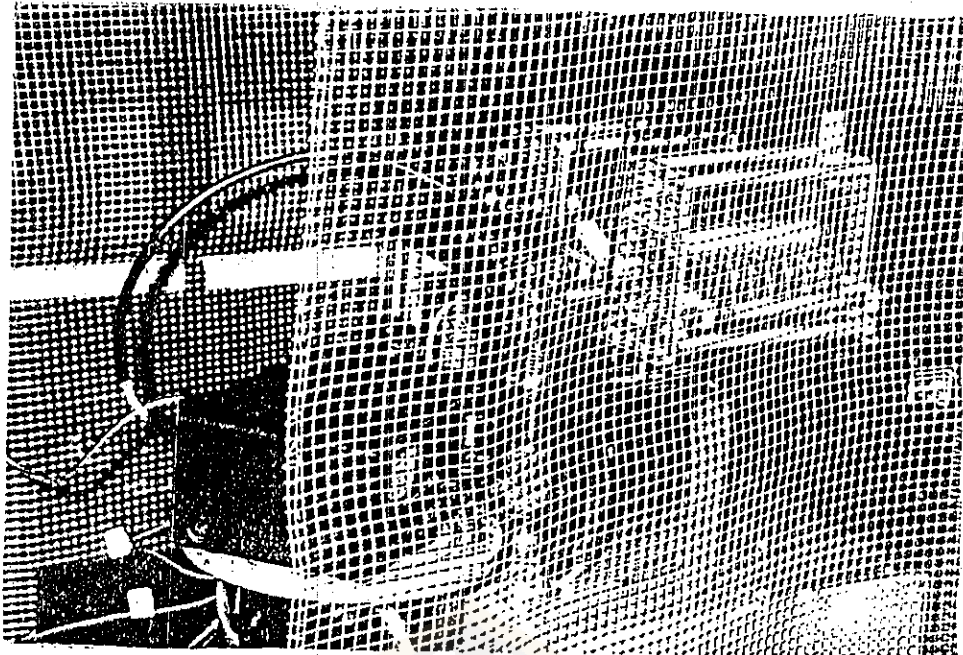


Gambar g-1 : Homogenitas lapisan toluena pada pemayaran dari sampel arah sb x

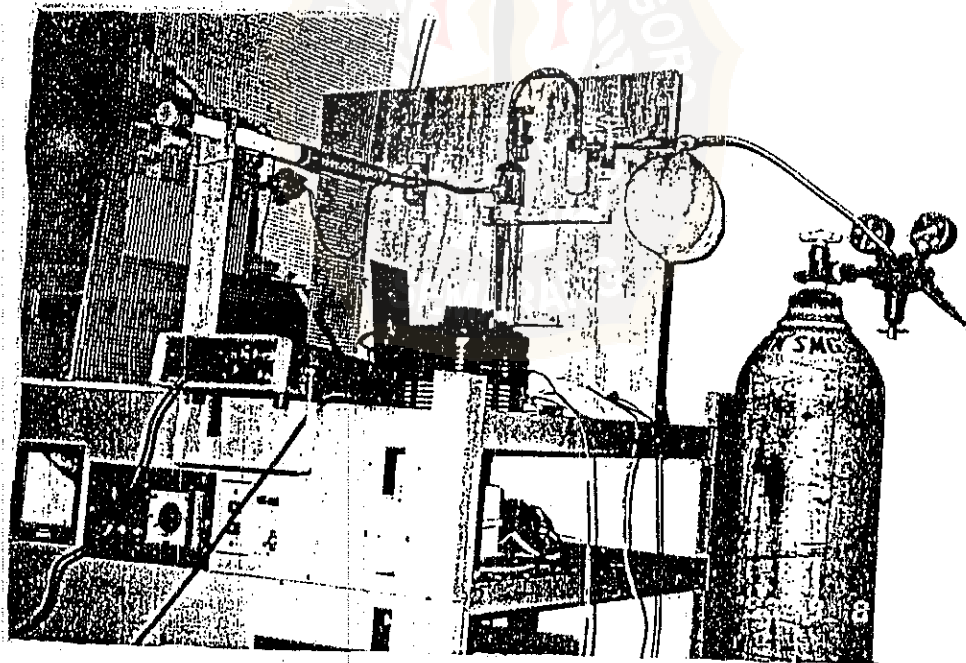


Gambar g-2 : Homogenitas lapisan toluena pada pemayaran dari sampel arah sb y

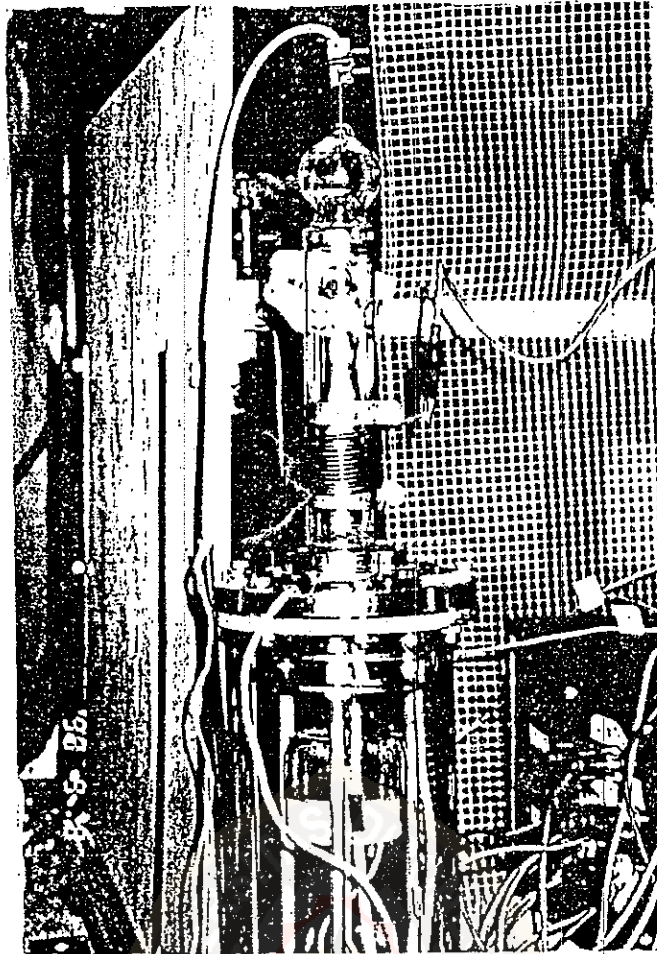
LAMPIRAN H : FOTO-FOTO SISTEM DEPOSISI ION POLIMERISASI PLASMA



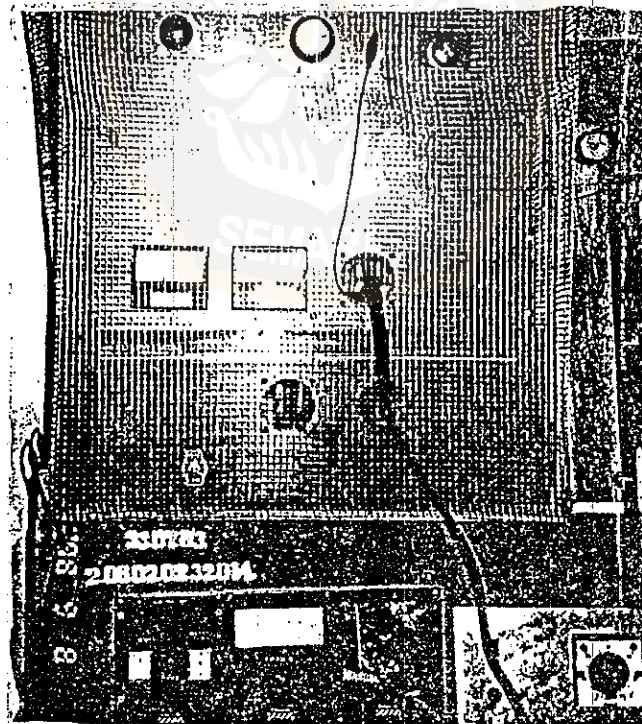
Gambar h-1 : Bagian dalam sistem RF



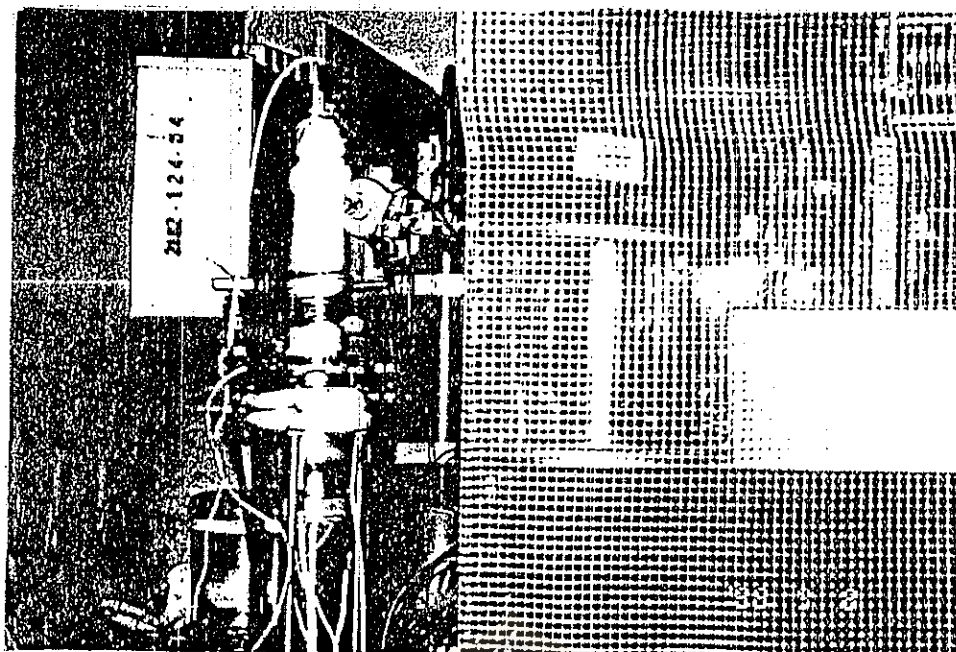
Gambar h-2 : Sebagian dari sistem deposisi ion



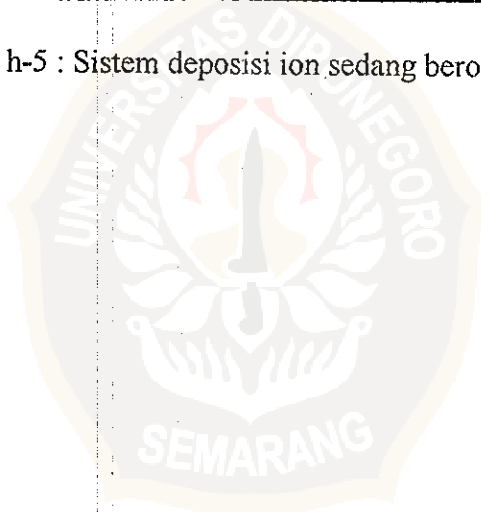
Gambar h-3 : Tabung reaktor plasma



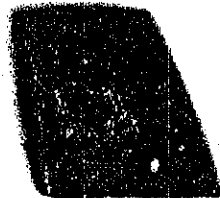
Gambar h-4 : Panel muka sistem RF



Gambar h-5 : Sistem deposisi ion sedang beroperasi



LAMPIRAN I : FOTO-FOTO DIODA SIL



Gambar i-1 : Keping silikon tipe p



Gambar i-2 : Dioda SIL akan diukur arus dan tegangannya